

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
28 octobre 2004 (28.10.2004)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2004/093202 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷ :
H01L 31/18, 31/0236

(21) Numéro de la demande internationale :
PCI/FR2004/050151

(22) Date de dépôt international : 9 avril 2004 (09.04.2004)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
03/04676 14 avril 2003 (14.04.2003) FR

(71) Déposants (pour tous les États désignés sauf US) :
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE [FR/FR]; 3, Rue Michel Ange, F-75794 Paris
Cedex 16 (FR). UNIVERSITE DE POITIERS [FR/FR];
15, Rue de l'Hôtel Dieu, F-86034 Poitiers Cedex (FR)

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : STRABONI,
Alain [FR/FR]; 6, Rue Marcel Pagnol, F-86180 Buxerolles
(FR)

(74) Mandataire : DE BEAUMONT, Michel; Cabinet Michel
De Beaumont, 1, Rue Champollion, F-38000 Grenoble
(FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AI,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,
MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,
PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM,
KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW); eurasien
(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM); européen (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR);
OAPI (BF, BI, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, IG).

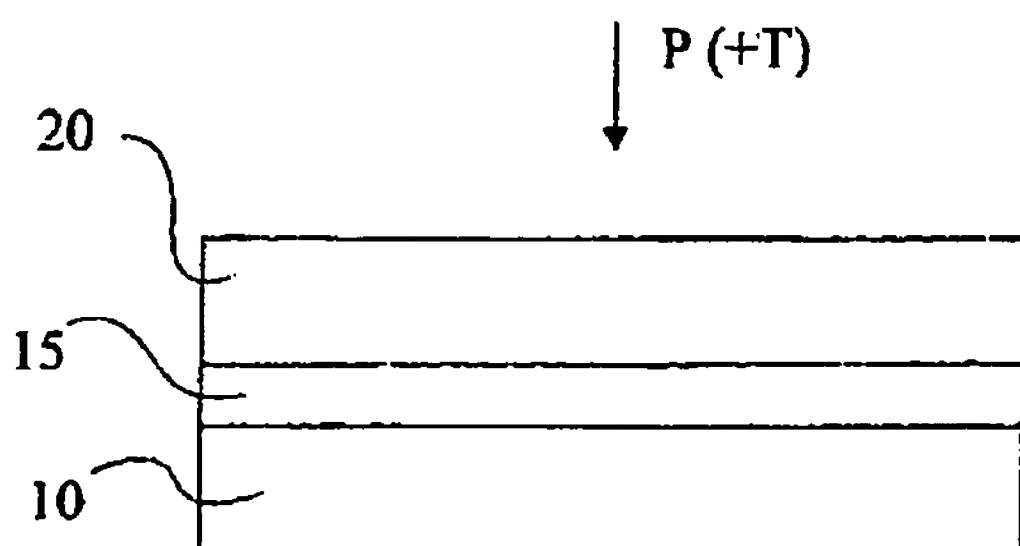
Publiée :

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des
revendications sera republiée si des modifications sont re-
çues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrégia-
tions, se référer aux 'Notes explicatives relatives aux codes et
abréviations' figurant au début de chaque numéro ordinaire de
la Gazette du PCT.

(54) Title: SINTERED SEMICONDUCTOR MATERIAL

(54) Titre : MATERIAU SEMICONDUCTEUR OBTENU PAR FRITTAGE



(57) Abstract: The invention relates to a method for
forming a semiconductor material obtained by sinter-
ing powders and to a semiconductor material. The
method comprises a compression and heat treatment
stage such that one part of the powder is melted or be-
comes viscous. The material can be used in the pho-
tovoltaic field

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé
de formation d'un matériau semiconducteur obtenu
par frittage de poudres ainsi qu'un matériau
semiconducteur. Le procédé comprend une étape de
compression et de traitement thermique tel qu'une
partie des poudres est fondue ou rendue visqueuse.

WO 2004/093202 A1

Le matériau est utilisable dans le domaine photovoltaïque